# иSR-исследования мультиферроиков-манганитов на синхроциклотроне НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ

## Лаборатория мезонной физики конденсированных сред С.И. Воробьев

Ядерный семинар ОФВЭ 6 июня 2017 г.



otation





Мюонный метод исследования вещества берет свое начало еще с работы Т. Ли и Ч. Янга, где впервые рассматривался вопрос о несохранении пространственной и зарядовой чётности в слабых взаимодействиях и предлагалось экспериментаторам искать нарушение ранее «незыблемого» закона сохранения природы в β-распаде поляризованных ядер и в распадах мезонов и гиперонов. Опыты, выполненные Ц. Ву, Е. Амблером и др. по изучению β-распада поляризованных ядер <sup>60</sup>Со и Р. Гарвина, Л. Лидермана и М. Вейнриха по изучению углового распределения электронов в распаде мюона, явились первыми экспериментальными доказательствами справедливости нарушения закона чётности в слабых взаимодействиях.

Но в 1957 году Р.Л. Гарвин, Л.М. Ледерман и Г. Вейнрих и Дж. И. Фридман, В.Л. Телегди, которые открыли несохранение четности в  $\pi \rightarrow \mu \rightarrow e$  распаде, вряд ли могли предположить, что этот фундаментальный результат в физике элементарных частиц положит начало новому методу изучения свойств вещества – µSR-методу. Т.е. в 2017 году µSR-методу 60 лет!

Суть мюонного метода исследования вещества заключается в возможности локальных микрополей в веществе с помощью изучения легкой нестабильной заряженной элементарной частицы (как мюона положительно заряженного μ+, отрицательный так И имеющего заряд µ<sup>-</sup>). Для изучения свойств материи наиболее электрический перспективны положительно заряженные мюоны.

В настоящее время в России существует единственная работающая µSRустановка, расположенная на выходе мюонного канала синхроциклотрона СЦ-1000, которому в ноябре этого года будет 50 лет с момента запуска.

В ПИЯФ µSR-метод начал развиваться после 1976 года, когда был пущен в эксплуатацию мюонный канал на синхроциклотроне СЦ-1000, тогда и начались первые экспериментальные исследования. µSR-методу в ПИЯФ, уже 40 лет!



Рис. 4. Три класса "ферроупорядоченных" веществ: сегнетоэлектрики, ферромагнетики (антиферромагнетики), сегнетоэластики. Каждый из классов характеризуется соответствующими петлями гистерезиса: P(E), M(H),  $\sigma(\varepsilon)$ , где  $\sigma$ ,  $\varepsilon$  — соответственно механические напряжение и деформация. Мультиферроики лежат на пересечениях этих множеств: P, M-E, H — область, соответствующая сегнетомагнетикам,  $P, \sigma-E, \varepsilon$  — сегнетоэлектрикам с сегнетоэластическими свойствами;  $M, \sigma-H, \varepsilon$  — веществам с магнитным и сегнетоэластическим упорядочениями.

[А.П. Пятаков, А.К. Звездин. УФН (2012) т.182, №6, 593]



Мультиферроиками (или сегнетомагнетиками в отечественной литературе) называют материалы, в которых сосуществуют одновременно два и более типов «ферро» упорядочения: ферромагнитное, сегнетоэлектрическое и сегнетоэластичность.

Впервые предположение возможности 0 сосуществования магнитного и электрического порядка в было одном кристалле сделано Пьером Кюри, теоретически показавшем, В кристаллах ЧТО С определённой симметрией могут одновременно существовать магнитное и электрическое упорядочения.

Экспериментально такие соединения были обнаружены в середине XX века и названы сегнетомагнетиками.

В 1958 году группа ленинградских физиков во главе с Г.А. Смоленским в ФТИ им. А.Ф. Иоффе обнаружила ряд сегнетоэлектриков структурой CO перовскита И значительным содержанием ионов железа. Последнее обстоятельство дало основание надеяться, ЧТО ЭТИ соединения могут быть одновременно сегнетоэлектриками и ферро(антиферро)магнетиками.

В мультиферроиках, помимо свойств, характерных для каждого типа упорядочения в отдельности (спонтанная намагниченность, магнитострикция, спонтанная поляризация и пьезоэлектрический эффект) присутствуют свойства, связанные с взаимодействием электрической и магнитной подсистем:

• магнитоэлектрический эффект (индуцированная магнитным полем электрическая поляризация и индуцированная электрическим полем намагниченность);

• эффект магнитоэлектрического контроля (переключение спонтанной поляризации магнитным полем и спонтанной намагниченности электрическим полем);

• магнитодиэлектрический эффект или «магнитоёмкость» (изменение диэлектрической постоянной под действием магнитного поля).

Существуют два основных типа мультиферроиков:

• мультиферроики I типа, в которых магнетизм и сегнетоэлектричество возникают независимо друг от друга;

• мультиферроики II типа, в которых появление сегнетоэлектрического упорядочения является следствием существования магнитного упорядочения.

Такие материалы замечательны тем, что их электрическими свойствами можно управлять с помощью магнитного воздействия и наоборот, что можно использовать для создания устройств хранения информации со сверхвысокой плотностью записи. Кроме того, они могут использоваться в качестве чувствительных магнитных датчиков, в микроволновых устройствах передачи информации и многих других приложениях.

В течение длительного времени магнитоэлектрики и мультиферроики являлись узкой и не слишком популярной областью исследования, так как малые величины магнитоэлектрических (МЭ) эффектов и низкие температуры, при которых они проявлялись, не позволяли говорить о их практическом применении. Однако с начала XXI века интерес к ним значительно возрос, так как выяснилось, что мультиферроики потенциально очень важны для будущего магнитного хранения данных и спинтронных устройств, предоставляя простой и быстрый способ изменения своих электрических и магнитных свойств.



**Рис. 1.** Количество публикаций по тематике магнитоэлектрических материалов и мультиферроиков в текущем столетии (по данным ISI Web of Knowledge).

Публикации ЛМФКС 2006-2016 гг.

Статьи в журналах – 9 шт. (ЖЭТФ, Письма в ЖЭТФ, ФТТ, ПТЭ, Известия РАН. Серия физическая)

Препринты ПИЯФ – 5 шт.

Тезисы конференций – 26 шт. российские конференции – 17, международные конференции – 9.

[А.П. Пятаков, А.К. Звездин. УФН (2012) т.182, №6, 593]



Особый интерес представляют мультиферроики-манганиты RMnO<sub>3</sub> и RMn<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, в которых сегнетоэлектрическое упорядочение индуцируется специальным типом магнитного порядка, понижающего симметрию кристалла до нецентросимметричной. Они обладают гигантским магнито-электрическим эффектом, что привлекает к ним внимание исследователей. Изучение особенностей магнитной структуры таких мультиферроиков является ключевым для понимания полярных и структурных их состояний.

Как известно, *µSR*-метод дает информацию о локальных внутренних полях упорядоченных магнетиков, в которых останавливаются и термализуются мюоны.

# Исследования свойств мультиферроиков Eu<sub>0.8</sub>Ce<sub>0.2</sub>Mn<sub>2</sub>O<sub>5</sub> и EuMn<sub>2</sub>O<sub>5</sub> с помощью µSR-метода

ЖЭТФ, 2016, том 150, вып. 6 (12), стр. 1170–1178. JETP, 2016, Vol. 123, № 6, pp. 1017–1024. **Манганиты RMn<sub>2</sub>O<sub>5</sub>** (R-редкоземельный ион) являются типичными представителями мультиферроиков, в которых сегнетоэлектрическое упорядочение при  $T < T_C \approx 30K - 35K$  индуцируется магнитным упорядочением с  $T_N \approx 40K - 45K$  и имеется сильное магнитоэлектрическое взаимодействие.

До последнего времени считалось, что  $RMn_2O_5$  имеют центросимметричную орторомбическую симметрию с пр.гр.*Рbam*. Зарядовое упорядочение ионов марганца переменной валентности вдоль оси *b* при возникновении магнитного порядка приводит к появлению нецентросимметричности и сегнетоэлектричества за счет обменной стрикции.

В работе [Phys.Rev.Lett. 114, 117601 (2015)] на основании тщательного структурного исследования при комнатной температуре было показано, что  $RMn_2O_5$  обладают нецентросимметричной пространственной группой *Pm*. Это допускает существование электрической поляризации в  $RMn_2O_5$  при комнатной температуре. Обнаруженные в работе моноклинные искажения были слабыми на фоне пр.гр.*Pbam*. Авторы не оспаривали хорошо установленные экспериментально низкотемпературные магнитные свойства и наличие магнитно-индуцированного сегнетоэлектричества в  $RMn_2O_5$ . Они полагали, что низкотемпературный полярный порядок сосуществует и усиливает высокотемпературную электрическую поляризацию иной природы.

Напомним, что *µSR*-метод дает информацию о магнитном состоянии кристалла и полученные нами результаты согласуются с низкотемпературными магнитными свойствами, описываемыми в рамках пр. гр. *Pbam*.

Элементарная ячейка RMn<sub>2</sub>O<sub>5</sub> содержит по одному иону Mn разной валентности (Mn<sup>3+</sup> и Mn<sup>4+</sup>), и распределение этих ионов в кристалле (зарядовое упорядочение) играет ключевую роль в определении их свойств.

### В RMn<sub>2</sub>O<sub>5</sub> имеются два типа зарядового упорядочения:

Первый обусловлен парным чередованием ферромагнитных и антиферромагнитных пар ионов  $Mn^{3+}-Mn^{4+}$  вдоль оси *b*. Различие величин косвенного антиферромагнитного обмена между антиферромагнитными парами и двойного обмена между ферромагнитными парами приводит к обменной стрикции, индуцирующей электрическую поляризацию при *T* < 30*K*-35*K*.

Второй тип зарядового упорядочения обусловлен распределением ионов в слоях перпендикулярных оси *c*. Ионы  $Mn^{4+}$  занимают позиции *z*=0.25*c* и (1-*z*)=0.75*c* в октаэдрическом кислородном окружении (MnO<sub>6</sub>); ионы  $Mn^{3+}$  находятся в позициях *z* = 0.5*c* в пятиугольных пирамидах (MnO<sub>5</sub>); ионы  $R^{3+}$  занимают позиции *z* = 0*c*.

Зарядовое упорядочение вдоль оси *с* обусловлено процессами фазового расслоения и самоорганизации носителей заряда, которые характерны для всех манганитов, содержащих ионы  $Mn^{3+}$  и  $Mn^{4+}$ . Фазовое расслоение приводит к формированию ферромагнитных проводящих областей внутри диэлектрической антиферромагнитной (парамагнитной) матрицы исходного кристалла. Динамически равновесные области фазового расслоения формируются при балансе сильных взаимодействий притяжения носителей заряда (двойной обмен, искажение решетки) и кулоновского их отталкивания. По этой причине фазовое расслоение существует от самых низких температур до температур выше комнатной.

# Кристаллическая структура



Пространственная группа - Pbam



Основной задачей данной работы является сравнительное исследование магнитных свойств соединений  $Eu_{0.8}Ce_{0.2}Mn_2O_5$  (ECMO) и  $EuMn_2O_5$  (EMO) с помощью  $\mu SR$ -метода.

Исследования проводились в нулевых внешних магнитных полях в диапазоне температур от 15*K* до 300*K*.

Мюонный метод исследования ( $\mu SR$ -метод) ранее был уже использован для изучения свойств мультиферроиков EuMn<sub>2</sub>O<sub>5</sub> [Письма в ЖЭТФ **91**, 561 (2010)] и GdMn<sub>2</sub>O<sub>5</sub> [ФТТ **55**, 422 (2013)]. Было обнаружено несохранение поляризации мюонов при переходе исследуемых образцов в магнитоупорядоченное состояние. Отмечалась важная роль процессов переноса заряда между парами ионов Mn<sup>3+</sup>-Mn<sup>4+</sup> при формировании дальнего магнитного порядка в этих мультиферроиках.

Измерения были выполнены на *µSR*-установке, расположенной на выходе мюонного канала синхроциклотрона ПИЯФ [ПТЭ **50**, 36 (2007)].

Использовался пучок положительно заряженных мюонов с импульсом  $p_{\mu}$ =90 МэВ/с, импульсным разбросом  $\Delta p_{\mu}/p_{\mu}$ (FWHM) =0.02 и продольной поляризацией  $P_{\mu} \sim 0.90$ -0.95.

Исследуемые образцы помещались в криостат, который позволял устанавливать температуру образцов в диапазоне 15*K*–300*K* с точностью ~ от 0.1 до 0.5*K*.

Оба образца были одинаковыми по геометрическим размерам и представляли собой керамические диски диаметром 30 мм и толщиной 12 мм, изготовленные с помощью технологии твердофазного синтеза. Методом рентгеновского фазового анализа была определена структура данных керамических образцов и подтверждена их однофазность. Размер зерен керамики составлял несколько десятков микрон.





#### Физические параметры µ-канала:

- интенсивность ≤ 10⁵ с-¹;
- $P_{\mu+} = 70 \div 130 \text{ M} \Rightarrow \text{B/c};$
- продольная поляризация мюонов 95%;
- максимальный размер пучка Ø 40 мм;
- размер исследуемых образцов Ø20 ÷ 50 мм
  - с толщиной по пучку  $4 \div 10$  г/см<sup>2</sup>.



Рис. Установка для µSR-экспериментов. (КГ – кольца Гельмгольца; КК – компенсирующие катушки; К – коллиматор; Ф1 и Ф2 – фильтры 1 и 2; ФЭУ – фотоэлектронный умножитель); С1 ÷ С4 – сцинтилляционные счётчики.

### Фотография µSR-установки



Особенности µSR-установки: • угловой захват е<sup>+</sup> от распада мюонов, остановившихся в мишени 0,5 стерадиан; •температурный диапазон 10 ÷ 300 К; •возможность работы работать во внешних поперечных магнитных полях до 1,5 кГс; •анализируемый временной интервал с момента остановки мюона 10 нс ÷ 10 мкс с точностью 0,8 нс.

[ПТЭ, том 50, № 6, 2007, стр. 36 – 42]

















**Рис.** Криостат и размещение образца в криостате для µSR-исследований. 1 и 2 (3 и 4)– входное и выходное горячие (холодные) окна соответственно; 5 – корпус криостата; 6 – камера криостата из бериллиевой бронзы; 7 – оправа для крепления образца.



### Измерения проводились в трех режимах охлаждения (нагревания) образцов:

**Первый режим (***RUN1***)** представлял собой охлаждение образца от температуры  $T \approx 290K$  до T = 41K с шагом  $\Delta T \approx 5K - 10K$  с остановками в промежуточных температурных точках, в которых проводился набор статистики в течение двух часов в режиме стабилизации температуры. Затем относительно быстрое охлаждение (~ 1 час) от температуры 41K до 15*K*; после этого производилось пошаговое нагревание образца ( $\Delta T \approx 2.5K$ ) с набором статистики в каждой промежуточной точке со стабилизацией температуры до конечной температуры T = 40K. В таком режиме охлаждения были исследованы оба образца.

Второй режим (*RUN2*) представлял собой быстрое (~1 час) охлаждение от температуры T = 290K до T = 15K с шагом 2.5K, после чего начинался процесс нагревания с остановками в заданных точках для набора статистики (~6 часов на каждую температурную точку). В этом режиме исследовался только образец ЕСМО.

**Третий режим** (*RUN3*) состоял в том, что осуществлялось быстрое охлаждение образца до температуры ~ 70K (~ 1 час), после чего производили пошаговое понижение температуры с шагом  $\Delta T = 5K$  с остановками в заданных температурных точках для набора статистики; время экспозиции составляло примерно два часа на каждую температурную точку. Таким способом охладили образец до температуры T = 15K. Затем проводили пошаговое нагревание образца от температуры T = 17.5K до конечной температуры  $T \approx 75K$  с шагом  $\Delta T = 5K$  с набором статистики в промежуточных температурных точках с экспозицией примерно два часа на точку. В данном режиме был исследован только образец ЕСМО.

В процессе эксперимента измерялись временные спектры позитронов от распада мюонов, остановившихся в исследуемых образцах. Измерения спектров производились в двух временных интервалах (10 мкс и 1.1 мкс) с ценой деления ~5 нс/канал и ~0.8 нс/канал соответственно. Временные спектры описывались следующим выражением:

$$N_e(t) = N_0 \cdot \exp(-t/\tau_\mu) \left[1 + a_s \cdot G_s(t) + a_b \cdot G_b(t)\right] + B, \tag{1}$$

где  $N_{\theta}$  – нормировочная константа,

 $\tau_u$  – время жизни мюона,

 $a_s$  и  $a_b$  – парциальные асимметрии позитронов распада мюонов, остановившихся в образце и в конструктивных элементах установки соответственно,

 $G_s(t)$  и  $G_b(t)$  – соответствующие функции релаксации поляризации мюонов,

В-фон случайных совпадений. (Величина и временная структура фона случайных совпадений

определяются из обработки начального участка временного спектра,

предшествующего моменту остановки мюона в образце).

Асимметрия  $a_b$  для каждого образца извлекаются из обработки временных спектров, измеренных во внешнем магнитном поле при температуре образцов ниже температуры Нееля  $(T < T_N)$ . В этом случае наблюдаемая амплитуда частоты прецессии в заданном внешнем магнитном поле равна вкладу  $a_b$  в полную асимметрию. Из этой же обработки находится скорость релаксации поляризации мюонов  $\lambda_b$ , остановившихся в конструктивных элементах. При обработке спектров, измеренных в нулевых внешних магнитных полях, использован следующий вид функции релаксации фоновой компоненты:  $G_b(t) = \exp(-\lambda_b \cdot t)$ . Для исследуемых керамических образцов  $a_b \approx 0.02$ , в то время как полная асимметрия  $a_F = a_s + a_b \approx 0.3$ .

Асимметрия  $a_F$  равна амплитуде прецессии спина мюона во внешнем магнитном поле при температуре образца выше температуры Нееля  $T_N$ . Начальная асимметрия распада мюонов, остановившихся в образце,  $a_s = a_F - a_b$  используется для перенормировки константы  $N_0$  при обработке временных спектров, измеренных в нулевом внешнем магнитном поле. Наблюдаемая остаточная асимметрия  $a_s$  зависит от температуры образца.



t, канал

При обработке экспериментальных данных использовалось стандартное предположение о факторизации функции релаксации:

$$G_s(t) = G_{st}(t) \cdot G_d(t), \tag{2}$$

где  $G_d(t) = exp(-\lambda t)$  - динамическая функция релаксации, а  $G_{st}(t)$  – статическая функция релаксации, вид и параметры которой определяются распределением локальных магнитных полей в зонах, предпочтительных для локализации мюона после его замедления в образце и завершения процесса его термализации. Такое представление функции релаксации  $G_s(t)$  справедливо в том случае, если скорость динамической релаксации существенно меньше скорости релаксации, связанной с разбросом локальных статических магнитных полей. Что касается исследуемых образцов, то это условие выполняется практически во всем диапазоне температур, при которых проводились измерения.

Статическую функцию релаксации в случае изотропного ферромагнетика (антиферромагнетика) при отсутствии внешнего магнитного поля можно представить следующим образом:

$$G_{st}(t) = \sum_{i} a_{i} \left[ \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cos(\Omega_{i}t) \exp(-\Delta_{i}t) \right].$$
(3)

Здесь  $a_i$  – парциальные амплитуды наблюдаемых частот прецессии спина мюона в локальном внутреннем магнитном поле. Частоты  $\Omega_i = 2 \cdot \pi \cdot F_i$  и скорости релаксации  $\Delta_i$  (дисперсия) зависят от величины локальных магнитных полей и от разброса этих полей в местах локализации мюона в образце. В квадратных скобках слагаемое 1/3 соответствует доле продольной компоненты в ориентации внутренних магнитных полей относительно направления спина мюона, а слагаемое с коэффициентом 2/3 соответствует доле поперечной компоненты в ориентации внутреннию к направлению спина мюона.

Используя соотношения (1−3) и принимая во внимание условие  $\lambda << \Delta$ , из экспериментальных временных спектров можно определить температурные зависимости параметров функции релаксации поляризации мюонов, остановившихся в каждом образце.

### Результаты и обсуждение.

На рис. 1 и 2 приведены остаточная асимметрия  $a_s$ , нормированная на  $a_0$ , и скорость релаксации  $\lambda$  для образцов ЕСМО и ЕМО в режиме *RUN1*.

Скачок относительной остаточной асимметрии  $a_s/a_0$  и максимум скорости релаксации  $\lambda$  соответствуют температуре установления дальнего магнитного порядка  $T_N \approx 45K$  для образца ЕМО и  $T_N \approx 42.5K$  для образца ЕСМО.

Следует отметить, что для обоих образцов ниже температуры магнитного упорядочения  $T_N$  наблюдается одинаковая потеря поляризации ~20% ( $a_s/a_0 < 1/3$ ). Это быстрая деполяризация за время меньше 9 нс («мёртвое» время установки). Можно объяснить её за счёт спин-спинового взаимодействия мюона с поляризованными электронами вблизи ферромагнитных пар Mn<sup>3+</sup>–Mn<sup>4+</sup>, которые появляются в результате туннелирования  $e_g$ -электронов в соседнюю плоскость, и образованием ферромагнитных комплексов Mn<sup>3+</sup>–Mn<sup>3+</sup>–Mu (Mu – связанное состояние  $\mu^+e^-$ ). В образце ЕСМО есть дополнительный канал образования ферромагнитных пар Mn<sup>3+</sup>–Mn<sup>4+</sup> за счет электронного легирования, но модифицированный таким образом объем образца мал, и поэтому потери поляризации в обоих образцах практически равны.



Рис.1. Температурная зависимость нормированной остаточной асимметрии для образцов ЕСМО (светлые точки) и ЕМО (тёмные точки) в режиме *RUN1*; пунктирной линией отмечен уровень *a<sub>s</sub>/a<sub>0</sub>=1/3*.

Рис.2. Температурная зависимость скорости релаксации поляризации мюонов, остановившихся в образцах ЕСМО (светлые точки) и ЕМО (тёмные точки) в режиме *RUN1*.

На рис. З приведена скорость релаксации  $\lambda$  для ЕСМО в трех режимах охлаждения (нагревания). Для режима *RUN2* имеет место особенность («плечо») в области температур 25*K*-40*K* и для удовлетворительного описания временных спектров требуется ввести ещё один динамический член в *G*-функцию в виде  $a_2 exp(-\lambda_2 t)$ :

### $G_s(t) = exp(-\lambda_1 t) \cdot G_{st}(t) + a_2 \cdot exp(-\lambda_2 t).$

На рис. 4 для сравнения демонстрируется различный характер релаксации поляризации мюона при температурах внутри этого диапазона (T=37.5K) и вне его (T=17.5K и T=70K). При этом для лучшего восприятия временные спектры были просуммированы по 10 каналов (~50 *нс*), чтобы усреднить быстрые осцилляции от прецессии магнитного момента мюона во внутреннем магнитном поле образца ниже температуры магнитного упорядочения  $T_N=42.5K$ .



Рис. 3. Температурная зависимость скорости релаксации поляризации мюонов, остановившихся в образце ЕСМО, для различных режимов охлаждения образца RUN1 (треугольники), RUN2 (светлые точки) и RUN3 (темные точки)



Рис. 4. Функции релаксации  $G_d(t)$  при температурах T = 70 К (треугольники), T = 37.5 К (светлые точки) и T = 17.5 К (темные точки) в режиме RUN2

На рис. 5 видно, что параметр λ<sub>2</sub> на порядок больше параметра λ<sub>1</sub>, который отвечает за медленную релаксацию поляризации. Какова доля мюонов, остановившихся в области со столь большой динамикой и нулевым средним магнитным полем за время наблюдения показано на рис. 6





Рис. 5. Эффект расслоения образца ЕСМО по скоростям релаксации поляризации мюонов в режиме измерения *RUN2*; светлые точки- медленно релаксирующая компонента(λ<sub>1</sub>), треугольникибыстро релаксирующая компонента (отложена величина λ<sub>2</sub>/10). Рис. 6. Температурные зависимости нормированной остаточной асимметрии для образца ЕСМО; *RUN1*-светлые треугольники; *RUN3* - тёмные точки; *RUN2*-(светлые точки - медленно релаксирующая компонента, тёмные треугольники - быстро релаксирующая компонента); пунктирной линией отмечен уровень *a<sub>s</sub>/a<sub>0</sub>=1/3*.



Существенную разницу в температурном поведении параметров функции релаксации для образца ЕСМО в диапазоне 25K-40K в режимах RUN1(RUN3) и RUN2 следует связывать с тем, как происходил процесс охлаждения (нагревания) образца: в режимах RUN1 и RUN3 точка фазового перехода при температуре  $T_N$ =42.5K проходилась медленно, в то время как в режиме RUN2 она была пройдена быстро. Как следствие, имеет место заметное различие функций релаксации G(t) в области температур 25K-45K.



Рис. 7. Функции релаксации *G(t)* при температуре *T*=37.5 *К* в режимах *RUN1* (светлые точки) и *RUN2* (темные точки).

Частота прецессии спина мюона  $\Omega_i = 2 \cdot \pi \cdot F_i$ пропорциональна среднему магнитному полю  $B_i = \Omega_i / \gamma$  в месте локализации мюона (здесь  $\gamma = 13.5544$  кГи/Гсгиромагнитное отношение для мюона).

**Частота**  $F_1$  не зависит от температуры в пределах ошибок. Из-за туннелирования электронов в каждой плоскости расположения ионов Mn появляются пары ионов Mn<sup>3+</sup>–Mn<sup>4+</sup>, которые становятся ферромагнитными в результате процесса двойного обмена электроном ионами. Однако, ферромагнитное между ЭТИМИ упорядочение этих пар отсутствует, и поэтому локальное магнитное поле вблизи этих пар не зависит от области температуры исключением вблизи за антиферромагнитного перехода.

Частота  $F_2$  увеличивается с понижением температуры по закону Кюри-Вейса  $F_2 \sim (1-T/T_N)^{\beta}$ ,  $T_N = 42.5K$  со степенным коэффициентом  $\beta = 0.29 \pm 0.02$ , который заметно отличается от аналогичного параметра  $\beta = 0.39 \pm 0.01$ , определенного для образца ЕМО и характерного для гейзенберговских антиферромагнетиков.

Существенное отличие коэффициента  $\beta$  в ЕСМО по сравнению с ЕМО свидетельствует о различии в температурном поведении их магнитных подсистем. Допирование образца приводит К TOMV, ЧТО антиферромагнитное упорядочение исходной матрицы в ECMO оказывается сильнее фрустрировано по сравнению с ЕМО. Это обстоятельство приводит к различию критических индексов для частот прецессии спинов мюона для основной матрицы ЕСМО и ЕМО.



Рис. 8. Температурная зависимость двух наблюдаемых частот прецессии спина мюона для образца ЕСМО, измеренная в режиме *RUN2 (F*<sub>1</sub>- тёмные точки, *F*<sub>2</sub>- светлые точки).

В температурном диапазоне 30*K*-40*K* доли частот  $F_1$  и  $F_2$  и их дисперсии примерно равны, т.е.  $a_1/a_0 \approx a_2/a_0$  и  $\Delta_1 \approx \Delta_2$ . Но при температурах ниже 30*K*, вклады  $a_1$  и  $a_2$  и соответствующие дисперсии  $\Delta_1$  и  $\Delta_2$  заметно различаются (рис. 9 и 10).

Отметим, что при приближении к 30К интенсивности ферромагнитных резонансов от слоев 1D-сверхрешеток в легированном кристалле резко падали [JETP Lett. 95, 386 (2012), Письма в ЖЭТФ 91, 561 (2010)], а также изменялся знак магнитосопротивления [Phys.Cond.Matter 23, 456003 (2011)]. Это связывалось с изменением концентрации носителей заряда в слоях сверхрешеток при изменении характера превалирующей проводимости от туннельной к прыжковой.



Рис.9. Температурная зависимость дисперсий, наблюдаемых двух частот прецессии спина мюона для образца ЕСМО, измеренная в режиме *RUN2* (Δ<sub>1</sub>– светлые точки, Δ<sub>2</sub>– тёмные точки).

Рис.10. Парциальные амплитуды частот прецессии спина мюона для образца ЕСМО, измеренные в режиме *RUN2* (*a*<sub>1</sub>/*a*<sub>0</sub> – светлые точки, *a*<sub>2</sub>/*a*<sub>0</sub> – тёмные точки).

#### Выводы:

Проведено сравнительное изучение релаксации поляризации мюонов в керамических образцах ЕМО и ЕСМО в одинаковых условиях охлаждения и нагревания (*RUN1*). Оказалось, что допирование образца приводит к незначительному сдвигу температуры магнитного фазового перехода ( $T_N$ =45K для ЕМО и  $T_N$ =42.5K для ЕСМО).

В обоих образцах обнаружены близкие по величине (~20%) быстрые потери поляризации мюонов в области температур ниже температуры магнитного упорядочения  $T_{N^*}$ . Этот эффект обусловлен появлением ферромагнитных пар ионов ( $Mn^{3+}+Mn^{4+}$ ) в антиферромагнитной матрице и механизмом образования ферромагнитных комплексов ( $Mn^{4+}+Mn^{4+}+Mu$ ). Появление примесных ионов ( $Mn^{3+}$ ) в плоскости ионов ( $Mn^{4+}$ ) возможно изза электронного легирования, с одной стороны, и за счёт туннелирования  $e_g$ -электронов из плоскости ( $Mn^{3+}$ ) в плоскость ( $Mn^{4+}$ ), причём во втором случае примесные ионы появляются в обеих плоскостях.

Для образца ЕСМО обнаружено различие в температурном поведении релаксации поляризации мюонов при разных способах охлаждения и нагревания в области несоразмерной фазы (25K-42K). Появление фазы с быстрой релаксацией в этой области имеет место только в режиме быстрого охлаждения до температур ниже температуры магнитного упорядочения и может быть связано с возникновением 1D-сверхрешеток и чередующихся ферромагнитных и проводящих слоев.

В структуре функции релаксации поляризации мюонов для образца ЕСМО наблюдаются две частоты прецессии магнитного момента мюона во внутреннем магнитном поле. Температурная зависимость высокой частоты следует закону Кюри–Вейса с показателем  $\beta$ =0.29±0.02, отличным от значения  $\beta$ =0.39, характерного для 3D-магнетиков гейзенберговского типа, и является следствием допирования образца и сильной фрустрации его структуры. Независимость низкой частоты от температуры обусловлена наличием одиночных ферромагнитных пар ионов Mn<sup>3+</sup>–Mn<sup>4+</sup>.

